

Presseinformation

Höhere diskrete Leistung: Infineon bringt neues TO-247PLUS-Gehäuse auf den Markt, das Stromstärken von bis zu 120 A ermöglicht

München, 24. November 2014 – Die Infineon Technologies AG erweitert das Portfolio für diskrete IGBT für Hochleistungsanwendungen um das TO-247PLUS-Gehäuse. Dieses neue Gehäuse ermöglicht die gemeinsame Verwendung eines 120 A IGBTs und einer Diode mit voller Nennleistung. Trotz der erhöhten Stromstärke entspricht der diskrete Leistungshalbleiter bei Bemaßung und Pin-out dem JEDEC-Standard für TO-247-3-Gehäuse. Das TO-247PLUS-Gehäuse kann in Industrieanwendungen wie zum Beispiel der unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS), Schweißen, Solartechnik und Industrieantrieben zum Einsatz kommen sowie in automobilen Anwendungen wie Umrichtersystemen von Antriebssträngen. Mit dem TO-247Plus-Gehäuse können die Leistung bestehender Designs gesteigert oder das thermische Management der Anwendungen verbessert werden. Beides wirkt sich allgemein positiv sowohl auf die Systemsicherheit als auch die Lebensdauer aus. Die höhere Stromstärkenkapazität des TO-247PLUS erlaubt darüber hinaus die Reduktion der Anzahl von parallel geschalteten Komponenten. Dies wiederum ermöglicht ein kompakteres Produktdesign.

Das neue Gehäuse ist für eine Clip- oder Druckmontage auf dem Kühlkörper ausgelegt. Diese Montagetechniken sorgen dafür, dass der Druck auf das Gehäuse gleichmäßig verteilt wird und bieten eine bessere Wärmeleitfähigkeit sowie höhere mechanische Stabilität selbst bei starken Vibrationen und mechanischen Erschütterungen.

Da das TO-247PLUS-Gehäuse keine Montagebohrung aufweist, kann im Vergleich zum standardmäßigen TO-247-Gehäuse eine um 70 % größere Siliziumfläche untergebracht werden. Außerdem sorgt es durch eine um 26 % größere wärmeleitfähige Fläche für einen um 20 % geringeren Wärmewiderstand $R_{th(jh)}$ als das standardmäßige TO-247-Gehäuse. Der TO-247PLUS-Gehäusekörper verfügt über spezielle „Plastic Trousers“ (Kunststoffhosen, Einkerbungen im Modul), die die Kriechstrecke um 2 mm auf 4,25 mm erhöht. Der

besondere Kunststoff des TO-247PLUS-Gehäuses zeichnet sich durch engere Toleranzen bei der Clip-montage aus. Zudem ermöglicht ein neuartiges Konzept für die Verbindung der Bonddrähte eine Erhöhung der Stromstärke des Gleichstrom-Kollektors von 80 A auf 160 A. Hiermit geht eine höhere Verlässlichkeit und eine längere Lebensdauer des IGBT einher.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Muster des neuen diskreten TRENCHSTOP IGBT TO-247PLUS-Gehäuses in den Ausführungen für 100 A und 120 A sind ab sofort verfügbar, die Massenproduktion ist für das erste Quartal 2015 geplant. Weitere Informationen zum neuen TO-247PLUS IGBT finden Sie unter www.infineon/TO-247PLUS.

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren:

[Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.